

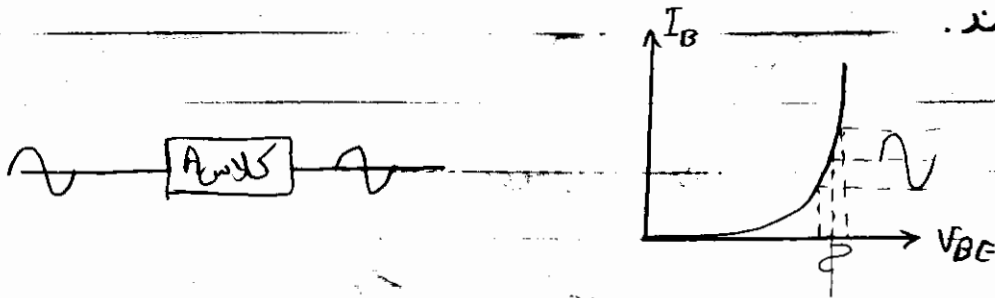
تقویت کننده قدرت

تقویت کننده کلاس A به تقویت کننده ای گفته می شود که اگر در ورودی سینوس داشته باشیم در

خروجی هم یک سیگنال سینوسی داشته باشیم. کلیه تقویت کننده هایی که تا بحال دیدیم از این نوع

بوده اند. اشکال این نوع تقویت کننده این است که توان آنها بالا است یعنی کلیه المان های مدار همواره

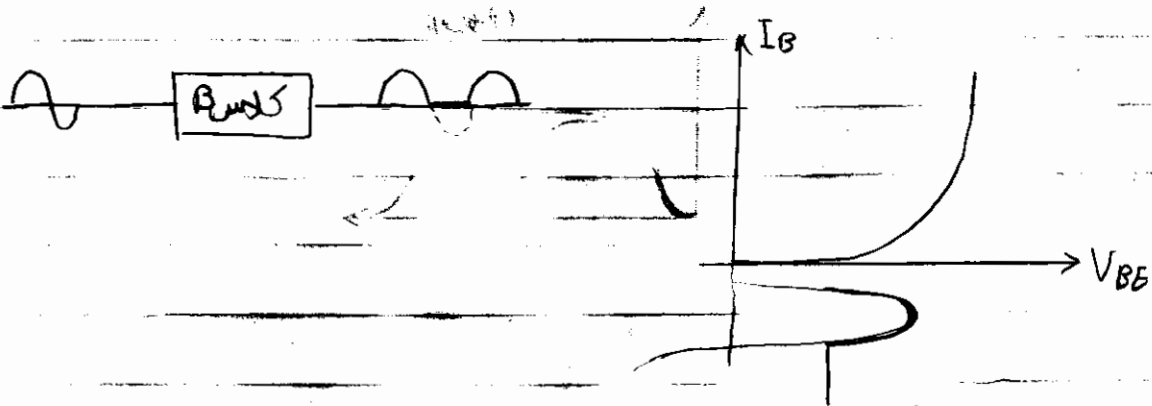
روشن هستند.



در تقویت کننده کلاس B تقویت کننده فقط یک آلترانساز ورودی را تقویت می کند. حسن

این تقویت کننده در این است که وقتی سیگنال نداریم تقویت کننده خاموش است در حالی که

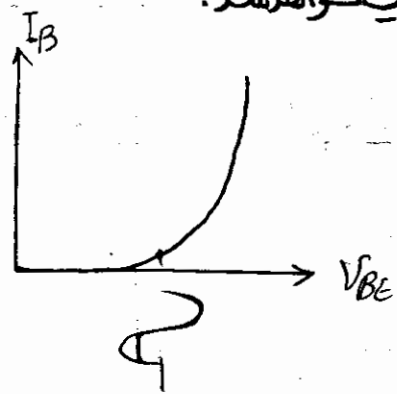
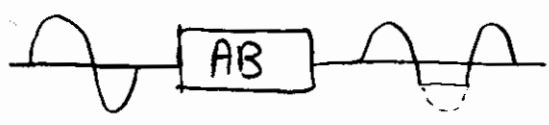
در کلاس A روشن خواهد بود.



در این حالت فقط کار در صفر است.

در تقویت کننده کلاس AB نقطه کار را کمی جلوتر می بریم در نتیجه مقدار بیشتری از کلاس

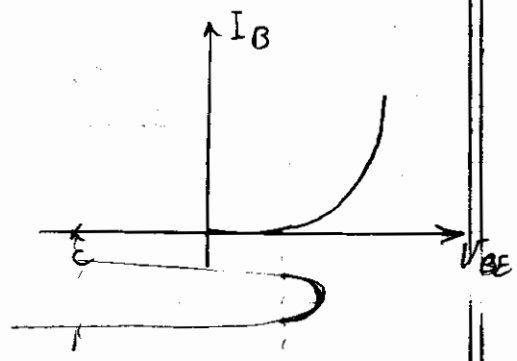
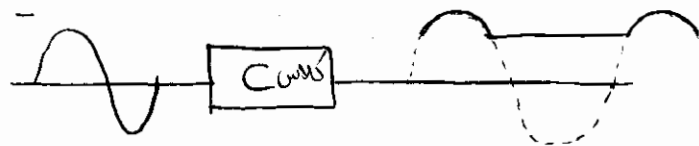
B تقویت خواهد شد.



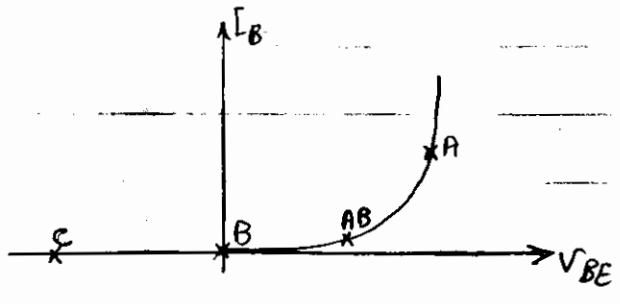
در تقویت کننده کلاس C نه تنها اینکه بایاس مثبت نیست بلکه منفی است و نقطه کار در طرف دیگر

منحنی V_{BE} خواهد بود. در نتیجه فقط pick سیگنال ورودی تقویت می شود و تلفات در

تقویت کننده از همه کلاس های دیگر کمتر خواهد بود.



نقاط کار کلاس های متفاوت در شکل زیر نمایش داده شده است.



کاربرد کلاس C در تقویت کننده های کلاس C مشابهی است که برای کم کردن تلفات می توان مصرفی

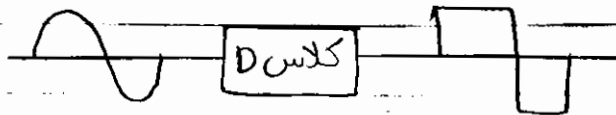
است.

در تقویت کننده کلاس D در ورودی سینوسی و در خروجی مربعی خواهد بود که برای

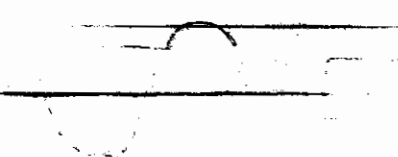
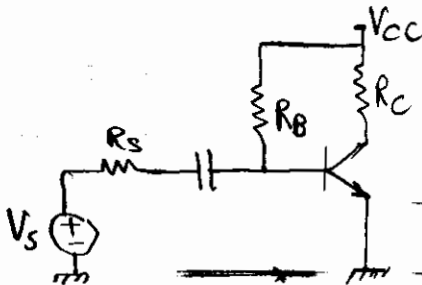
دیجیتال کردن سیگنال به کار می رود. در این کلاس نقطه کار را تعیین نمی کنیم چون اهمیتی

ندارد و دلخواه خواهد بود. آنچه که مهم است این است که سیگنال طوری باشد که تقویت کننده

به طور بیایی به ناحیه قطع و اشباع وارد نشود تا موج مربعی درست شود.



تقویت کننده ترانزیستوری کلاس A:



تمام شرایط را ایده آل می گیریم و راندمان این تقویت کننده را محاسبه می کنیم. بدین معنی که

از R_E ، R_1 و R_2 و R_L صرف نظر می کنیم و به جای R_1 و R_2 از R_B و به جای R_L از R_C استفاده

شرط یک تقویت کننده توان این است که

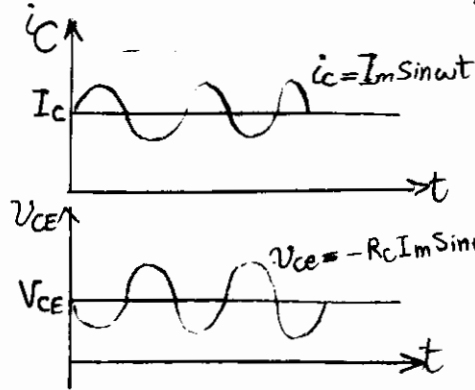
۱- افزایش توان — $P_o > P_i$ — ۲- توان قابل ملاحظه در خروجی

۳- راندمان بالا باشد. $\eta = \frac{\text{توان مفید دریافتی}}{\text{توان مصرفی}}$

توان مصرفی = P_S

توان دریافتی = P_{R_L}

توان تلفاتی = P_d



$$i_c = i_c + I_c$$

$$V_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$$

توان تلفاتی
 لحظاتی $P_d = i_B \times V_{BE} + i_c \times V_{CE}$

$$\rightarrow P_d = (i_c + I_c)(V_{CE} + v_{ce}) = (I_m \sin \omega t + I_c)(V_{CE} - R_c I_m \sin \omega t)$$

$$\rightarrow P_d = I_m V_{CE} \sin \omega t - R_c I_m^2 \sin^2 \omega t + V_{CE} I_c - R_c I_c I_m \sin \omega t$$

متوسط $P_d = V_{CE} I_c - \frac{R_c I_m^2}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t dt = V_{CE} I_c - \frac{1}{2} R_c I_m^2$

$$\rightarrow \text{متوسط } P_d = V_{CE} I_c - \frac{1}{2} R_c I_m^2$$

$P_{d \max} = V_{CE} \cdot I_c$ وقتی که سیگنال ورودی صفر است.

Sin wt

$$P_{R_L} = R_c i_c^2 = R_c (I_m \sin \omega t + I_c)^2 = R_c I_c^2 + R_c I_m^2 \sin^2 \omega t + 2 R_c I_c I_m \sin \omega t$$

توان دریافتی
 متوسط $P_{R_L} = R_c I_c^2 + \frac{R_c I_m^2}{2}$ $\xrightarrow{\text{توان مفید دریافتی}}$ $P_{R_L} = \frac{R_c I_m^2}{2}$

$$P_S = i_c \times V_{CC} \xrightarrow{P_S} P_{R_L} + P_d = R_c I_c^2 + \frac{R_c I_m^2}{2} + V_{CE} I_c - \frac{R_c I_m^2}{2}$$

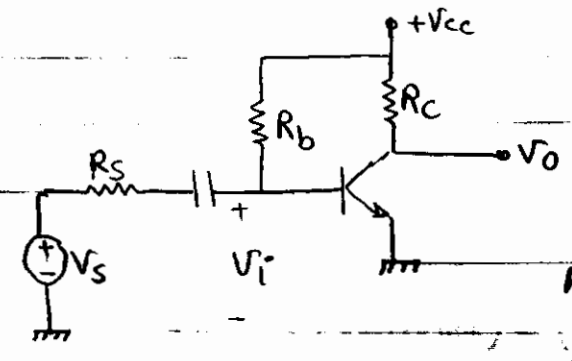
$$P_S = I_c (R_c I_c + V_{CE}) = I_c V_{CC} \rightarrow P_S = I_c \cdot V_{CC}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_s} = \frac{R_c I_m^2}{V_{CC} I_c}$$

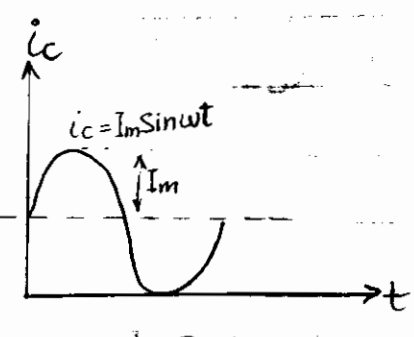
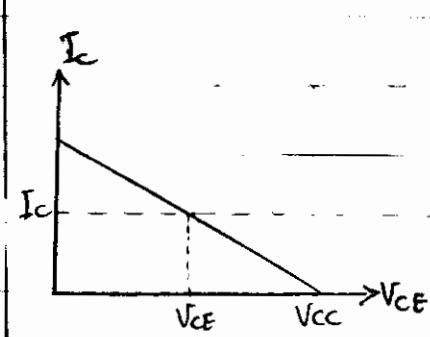
$$\eta_{max} = \frac{R_c I_c^2}{V_{CC} I_c} = \frac{R_c I_c}{V_{CC}} = \frac{1}{F}$$

$$\eta_{max} = \frac{1}{F}$$

تقویت کننده توان:



$$\eta = \frac{1}{F} \frac{R_c I_m^2}{V_{CC} \cdot I_c}$$



۱- نقطه کار وسط خط بار:

$$\begin{cases} V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2} \\ I_m = I_c \end{cases}$$

$$P_{dmax} = V_{CE} \cdot I_c = \frac{V_{CC}}{2} \cdot I_c = \frac{P_T}{2} = V_{CE} \times \frac{V_{CE}}{R_c} = \frac{V_{CE}^2}{R_c} = \frac{V_{CC}^2}{4R_c}$$

$$\rightarrow P_{dmax} = \frac{V_{CC}^2}{4R_c}$$

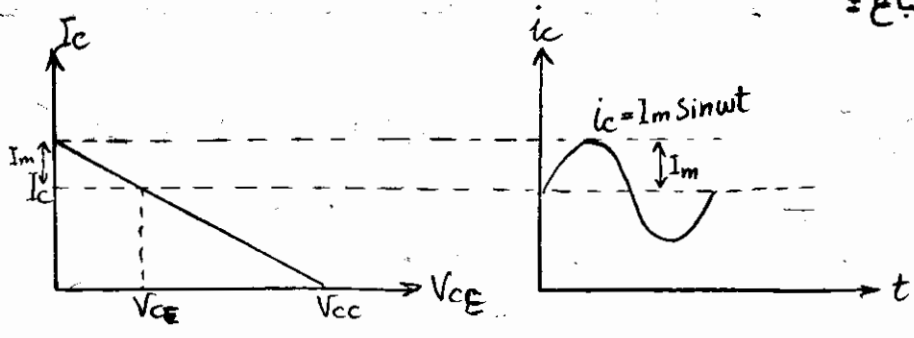
$$P_{ac} = \frac{1}{2} R_c I_m^2 = \frac{1}{2} R_c I_c^2 = \frac{1}{2} R_c \cdot \left(\frac{V_{CE}}{R_c}\right)^2 = \frac{V_{CE}^2}{2R_c} = \frac{V_{CC}^2}{4R_c}$$

$$\rightarrow P_{ac} = \frac{V_{CC}^2}{4R_c}$$

$$P_t = V_{CC} \cdot I_c = V_{CC} \cdot \frac{V_{CE}}{R_c} = \frac{V_{CC}^2}{2R_c} \rightarrow P_t = \frac{V_{CC}^2}{2R_c}$$

$$\eta_{max} = \frac{P_{acmax}}{P_t} = \frac{\frac{V_{CC}^2}{4R_c}}{\frac{V_{CC}^2}{2R_c}} = 0.5$$

۲- نقطه کار نزدیک ناحیه اشباع =



$$V_{CE} < \frac{V_{CC}}{2}$$

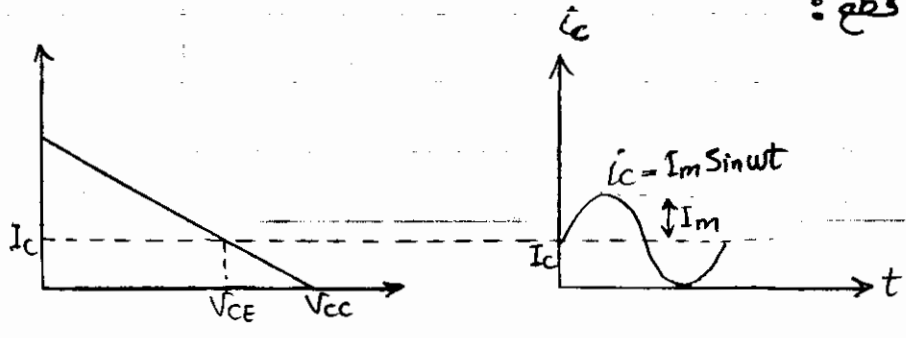
$$P_{dmax} = V_{CE} \cdot I_c < \frac{V_{CC}}{2} \cdot I_c = \frac{P_t}{2}$$

$$P_{ac} = \frac{1}{2} R_c I_m^2 = \frac{1}{2} R_c \left(\frac{V_{CE}}{R_c} \right)^2 = \frac{V_{CE}^2}{2 R_c} < \frac{V_{CC}^2}{4 R_c} = \frac{P_t}{2}$$

$$P_t = V_{CC} \cdot I_c = V_{CC} \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c} \right) > V_{CC} \cdot \frac{V_{CC}}{2 R_c} = \frac{V_{CC}^2}{2 R_c}$$

$$\eta_{max} = \frac{P_{ac}}{P_t} < \frac{1}{2}$$

۳- نقطه کار نزدیک ناحیه قطع =



$$\begin{cases} V_{CE} > \frac{V_{CC}}{2} \\ I_m = I_c \end{cases}$$

$$P_{dmax} = V_{CE} I_c > \frac{V_{CC}}{2} \cdot I_c = \frac{P_t}{2}$$

$$P_{ac} = \frac{1}{2} R_c I_m^2 = \frac{1}{2} R_c I_c^2 = \frac{1}{2} R_c \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c} \right)^2 = \frac{(V_{CC} - V_{CE})^2}{2 R_c} < \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} \right)^2}{2 R_c} = \frac{V_{CC}^2}{8 R_c}$$

$$P_t = V_{CC} \cdot I_c = V_{CC} \cdot \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c} \right) < V_{CC} \cdot \frac{V_{CC}}{2 R_c} = \frac{V_{CC}^2}{2 R_c}$$

$$\eta_{max} = \frac{P_{ac}}{P_t} = \frac{\frac{(V_{CC} - V_{CE})^2}{2 R_c}}{V_{CC} \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c} \right)} = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{2 V_{CC}} < \frac{V_{CC}}{2 \times 2 V_{CC}} = \frac{1}{4}$$

در محاسبات بالا ناحیه قطع و اشباع را برای ترانزیستور در نظر نگرفتیم. اگر ترانزیستور واتنی بوده

و نوعی قطع و اشباع داشته باشد، بسته به این نوعی راندمان از ۵۰٪ نیز کاهش می یابد. همچنین

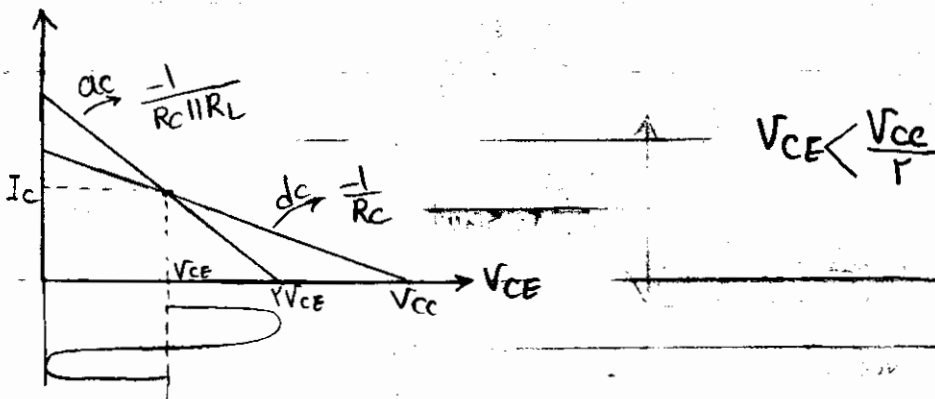
وجود مقاومت R_E نیز باعث کاهش راندمان خواهد شد.

تأثیر R_L بر راندمان:

با فرض اینکه نقطه کار وسط خط بار a_c است محاسبات

را انجام می دهیم:

اکتاس $\rightarrow \eta = \frac{\frac{1}{2} R_C I_m^2}{V_{CC} \cdot I_C}$



$$P_{dmax} = V_{CE} I_C < \frac{P_T}{2} \quad \text{و } V_{CE} < \frac{V_{CC}}{2}$$

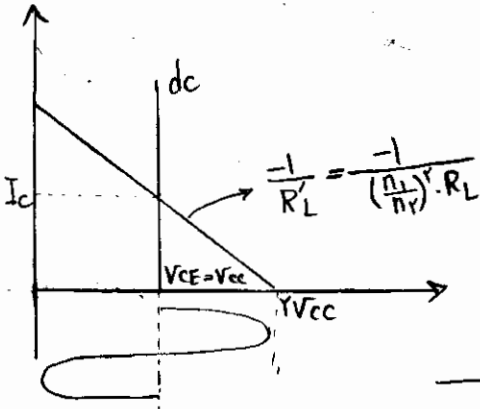
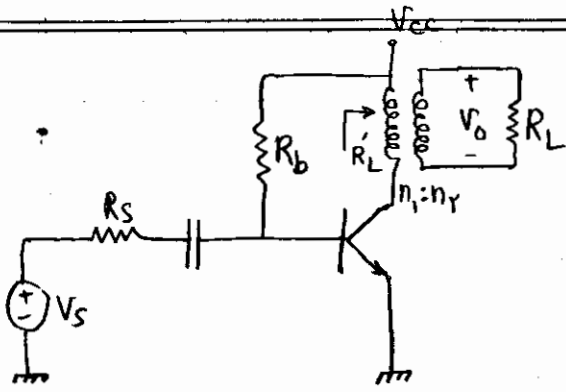
$$P_{ac} = \frac{1}{2} R_C I_m^2 = \frac{V_{CE}^2}{2 R_L} < \frac{V_{CE}^2}{2 (R_C || R_L)}$$

$$P_T = V_{CC} \cdot I_C > 2 V_{CE} \cdot I_C = 2 V_{CE} \cdot \frac{V_{CE}}{R_C || R_L} = \frac{2 V_{CE}^2}{R_C || R_L}$$

توان تلفاتی

$$\rightarrow \eta_{max} = \frac{P_{ac}}{P_T} < \frac{1}{4}$$

بافوض ترانس ابره ال



$$P_{dmax} = V_{CE} I_c = V_{CC} I_c = P_t$$

$$P_{ac} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(\frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \cdot V_{CE})^2}{2R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2(\frac{\beta_F}{\beta_F + 1})^2 R_L}$$

$$P_t = V_{CC} \cdot I_c = V_{CC} \cdot \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{(\frac{\beta_F}{\beta_F + 1})^2 R_L}$$

$$\eta_{max} = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$\eta_{max} = \eta_T \cdot \eta_C$$

در حالت ترانس واقعی :

در این حالت نیز وجود نولجی قطع و اشباع و یا قراردادن مقاومتهای R_T, R_i, R_E باعث کاهش راندمان خواهد شد.

معمولاً محاسبات فوق در دمای ثابت $T = 25^\circ C$ انجام می گیرد. سه روش برای تبادل حرارتی

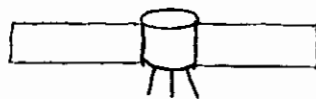
ترانزیستور با محیط وجود دارد :

تلفات حرارتی در ترانزیستور :

1) Conduction

هدایت } از پیوند به بدنه
از بدنه به پیوند

2) radiation



قراردادن رادیاتور
heat sink

بین رادیاتور و ترانزیستور از خمیر سلیکون استفاده می کنند که تبادل حرارتی با محیط را تقریباً

۷۰٪ معادل می برد.

۳) Convection استفاده از

ماکزیمم دمای تحملی می شود

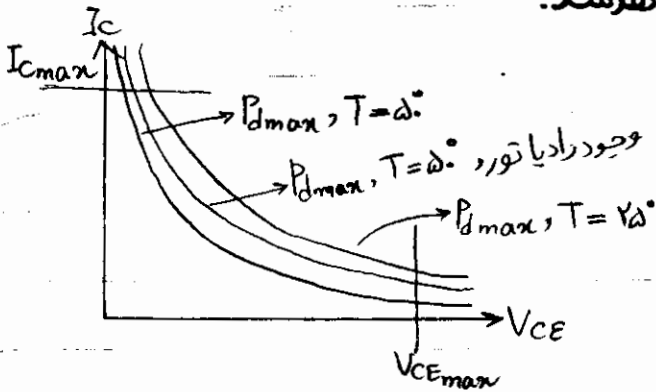
$$P_{dmax} = \frac{\Delta T}{R_{th}} = \frac{T_{jmax} - T_A}{R_{th}}$$

دمای محیط T_A

مقاومت گرمایی در برهه $\frac{^{\circ}C}{mW}$ یا $\frac{^{\circ}C}{W}$

توان تلفاتی

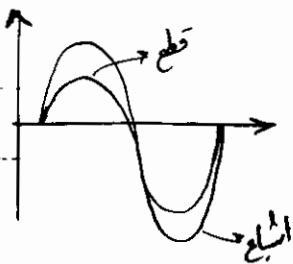
قراردادن رادیاتور باعث افزایش R_{th} خواهد شد.



مثال: در ترانزیستور BC107 پارامترهای مقابل را داریم:

$$T_{jmax} = 175^{\circ}C, \begin{cases} R_{thj-c} = 1/2 \text{ } ^{\circ}C/mW \\ R_{thj-a} = 1/5 \text{ } ^{\circ}C/mW \end{cases}$$

اثر اعوجاج بر کاهش راندمان:



$$V_o = V_1 \sin \omega t + V_2 \sin 2\omega t + V_3 \sin 3\omega t + \dots + V_n \sin n\omega t$$

$$P = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{1}{R_L} (V_1 \sin \omega t + V_2 \sin 2\omega t + \dots + V_n \sin n\omega t)^2$$

$$= \frac{1}{R_L} (V_1^2 \sin^2 \omega t + V_2^2 \sin^2 2\omega t + \dots + V_n^2 \sin^2 n\omega t) + 2V_1 V_2 \sin \omega t \sin 2\omega t + \dots$$

$V_1 V_2 \cos \omega t - V_1 V_2 \cos 3\omega t$

$$\begin{aligned} \rightarrow P_{ac} &= \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_1^r}{r} + \frac{V_2^r}{r} + \dots + \frac{V_n^r}{r} \right) \\ &= \frac{V_1^r}{r R_L} \left(1 + \frac{V_2^r}{V_1^r} + \dots + \frac{V_n^r}{V_1^r} \right) \end{aligned}$$

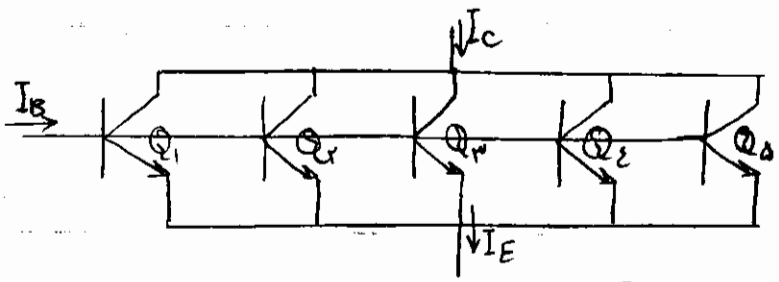
if $\frac{V_2^r}{V_1^r} = D_2, \frac{V_3^r}{V_1^r} = D_3, \dots$
 $\left\{ \begin{array}{l} \frac{V_1^r}{r R_L} \text{ توان هارمونیک اول} \\ \frac{V_2^r}{r R_L} \text{ توان هارمونیک دوم} \end{array} \right.$

$$\rightarrow P_{ac} = \frac{V_1^r}{r R_L} (1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n) = \frac{V_1^r}{r R_L} (1 + D^2)$$

total harmonic distortion $\rightarrow THD = D = \sqrt{D_2^2 + D_3^2 + \dots + D_n^2}$

$$, P_{ac} = \frac{V_1^r}{r R_L} (1 + D^2)$$

تکنیک موازی کردن ترانزیستورهای کم وات و استفاده کردن مجموعه به جای یک ترانزیستور بزرگ:



$$\begin{aligned} I_B &= I_{B1} + I_{B2} + I_{B3} + I_{B4} + I_{B5} \\ V_{BE1} &= V_{BE2} = V_{BE3} = V_{BE4} = V_{BE5} \end{aligned}$$

با توجه به اینکه جریان IC مقدار زیادی دلو (به عنوان مثال ۹A) استفاده از تعداد ترانزیستور

بیشتر اطمینان مورد نیاز را می‌کند و از سوختن ترانزیستورها جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال

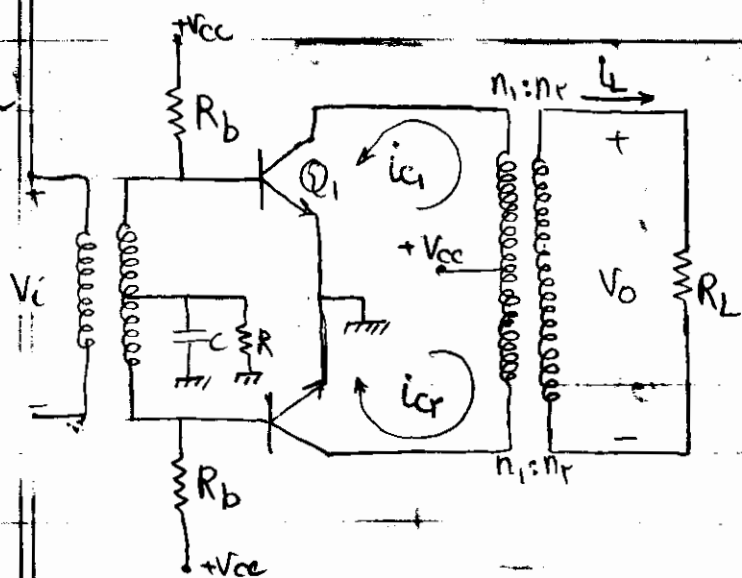
اگر از ۳ ترانزیستور ۳۵ استفاده می‌کردیم چون یا اامتر هر سه ممکن است با هم برابر نباشد

در نتیجه جریان به صورت مساوی تقسیم نمی شود و ممکن است یکی از ترانزیستورها بیشتر

از جریان بکشد و بسوزد و ولی استفاده از دو ترانزیستور این اشکال را رفع می کند.

این نوع بسس ترانزیستورها مقرون به صرفه تر از استفاده از یک ترانزیستور پروات است.

تقویت کننده تیوش پول کلاس A = (Push Pull A)



$$V_o = I_L \times R_L$$

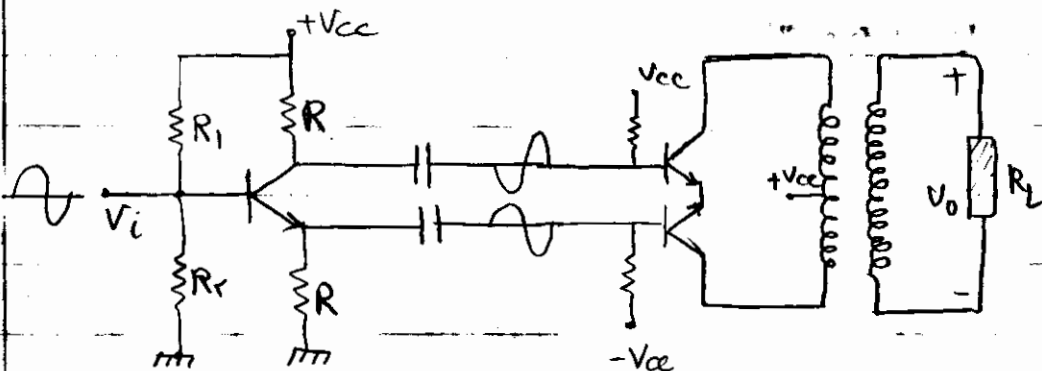
$$V_o = (i_{c1} - i_{c2}) \frac{n_2}{n_1} \times R_L$$

$$V_o = h_{fe} (i_{b1} - i_{b2}) \frac{n_2}{n_1} \times R_L$$

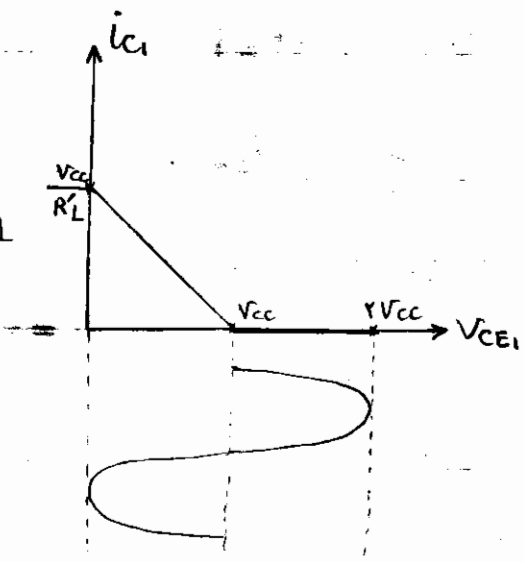
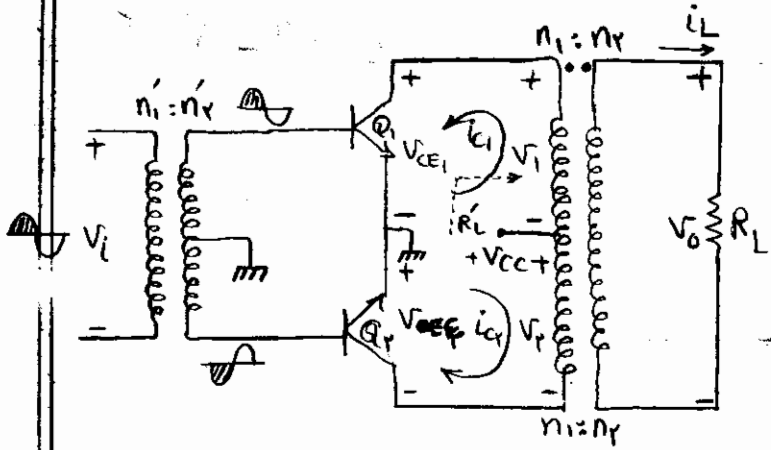
$$V_o = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} (V_{i1} - V_{i2}) \frac{n_2}{n_1} \times R_L$$

در این تکنیک دامنه ولتاژ خروجی افزایش می یابد اما دامنه از پهنای باند تغییر می نو کند لذا

از این نوع موزی کردن کمتر استفاده می شود (در مصارف کم وات از این نوع استفاده می کنیم)

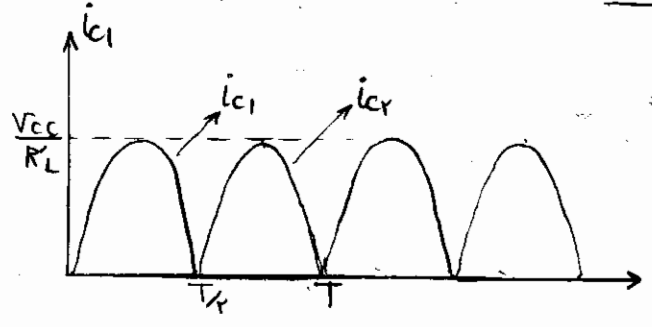


تقویت کننده پوش پول کلاس B =



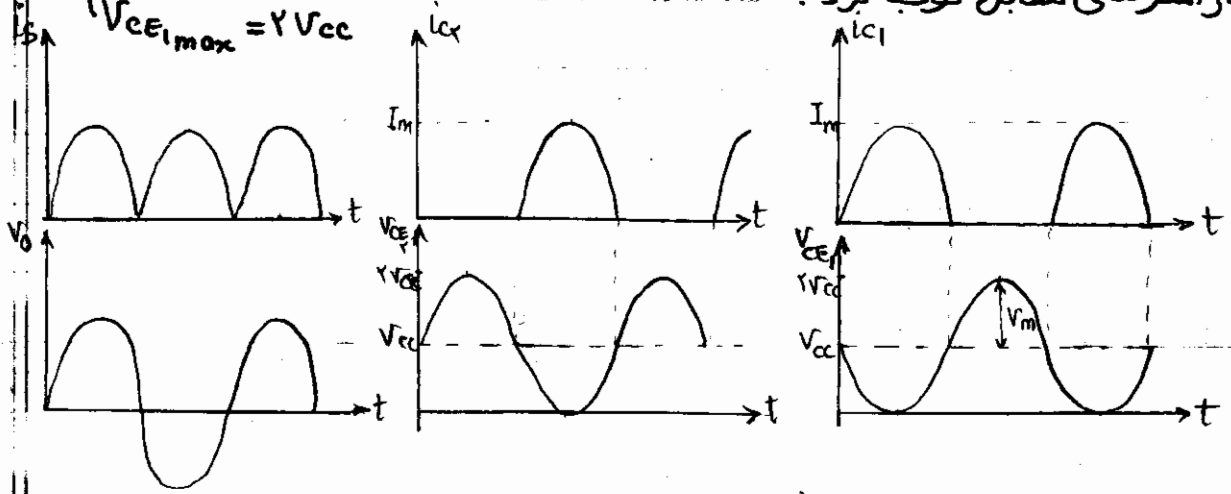
$$\begin{cases} V_{CE1} = V_1 + V_{CC} \\ V_{CE2} = V_{CC} - V_2 \end{cases}$$

در بیک منفی سگنال ورودی $\rightarrow V_{CE2} = 0 \rightarrow V_2 = V_{CC} \xrightarrow{\text{الق}}$ $V_1 = V_{CC} \rightarrow V_{CE1} = 2V_{CC}$



توجه به نمودارهای بالا باید در انتخاب ترانزیستور Φ به پارامترهای مقابل توجه کرد:

$$\begin{cases} I_{C_{av}} = \frac{I_m}{\pi} = \frac{V_{CC}}{R_L \cdot \pi} \\ I_{C_{1p}} = \frac{V_{CC}}{R_L} \\ V_{CE1_{max}} = 2V_{CC} \end{cases}$$



$$P_{Lmax} = V_{L_{eff}} \cdot I_{L_{eff}} = \frac{V_{Lm}}{\sqrt{r}} \cdot \frac{I_{Lm}}{\sqrt{r}} = \frac{V_{Lm} \cdot I_{Lm}}{r} = \frac{V_m \cdot \frac{n_1}{n_2} \cdot I_m \cdot \frac{n_1}{n_2}}{r} = \frac{V_m I_m}{r}$$

$$P_S = \frac{1}{T} \int_0^T i_s \cdot V_{cc} dt = \frac{r V_{cc}}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_m \sin \omega t dt = \frac{r V_{cc} \cdot I_m}{T} \cdot \left. \frac{-1}{\omega} \cos \omega t \right|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{r V_{cc} \cdot I_m}{\pi}$$

$$\rightarrow \eta_{max} = \frac{P_{Lmax}}{P_{Smax}} = \frac{\frac{V_m I_m}{r}}{\frac{r V_{cc} \cdot I_m}{\pi}} = \frac{\pi}{r} = \% \text{ VAID} \rightarrow \eta_{max} = \% \text{ VAID}$$

توان تلف

$$P_Q = \frac{1}{T} \int_0^T i_{c1} \cdot V_{ce1} dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} (I_m \sin \omega t) (V_{cc} - V_m \sin \omega t) dt$$

$$= \frac{I_m}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} (V_{cc} \sin \omega t - V_m (1 - \cos \omega t)) dt = \frac{V_{cc} \cdot I_m}{\pi} - \frac{V_m I_m}{r}$$

$$\rightarrow P_Q = \frac{V_{cc} I_m}{\pi} - \frac{V_m I_m}{r} \xrightarrow{V_m = V_{cc}} P_Q = \frac{V_{cc} I_m}{\pi} - \frac{V_{cc} I_m}{r} = V_{cc} I_m \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{r} \right)$$

$$\rightarrow P_Q = \% \text{ II } P_{Smax} = \% \text{ II } P_{Lmax}, \quad V_m = V_{cc}$$

$$P_Q = \frac{V_{cc} I_m}{\pi} - \frac{V_m I_m}{r}, \quad I_m = \frac{V_m}{R'_L} = \frac{V_m}{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_L}, \quad \frac{\partial P_Q}{\partial V_m} = 0$$

$$\rightarrow P_Q = I_m \left(\frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{V_m}{r} \right) = \frac{V_m}{R'_L} \left(\frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{V_m}{r} \right)$$

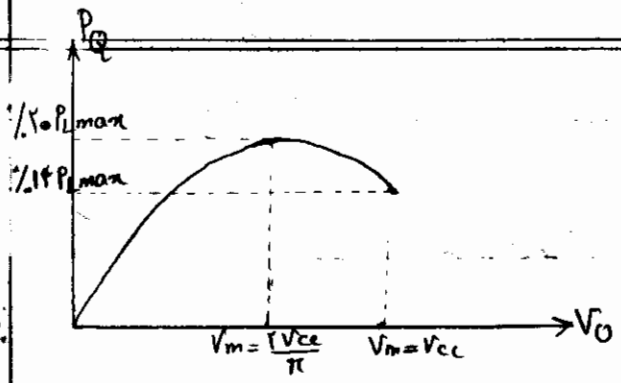
$$\frac{\partial P_Q}{\partial V_m} = \frac{1}{R'_L} \left(\frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{V_m}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{V_m}{R'_L} = 0 \rightarrow \boxed{V_m = \frac{r V_{cc}}{\pi}}$$

$$\rightarrow P_{Qmax} = \frac{r V_{cc}}{\pi R'_L} \left(\frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{V_{cc}}{r} \right) = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R'_L} \rightarrow P_{Qmax} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R'_L}$$

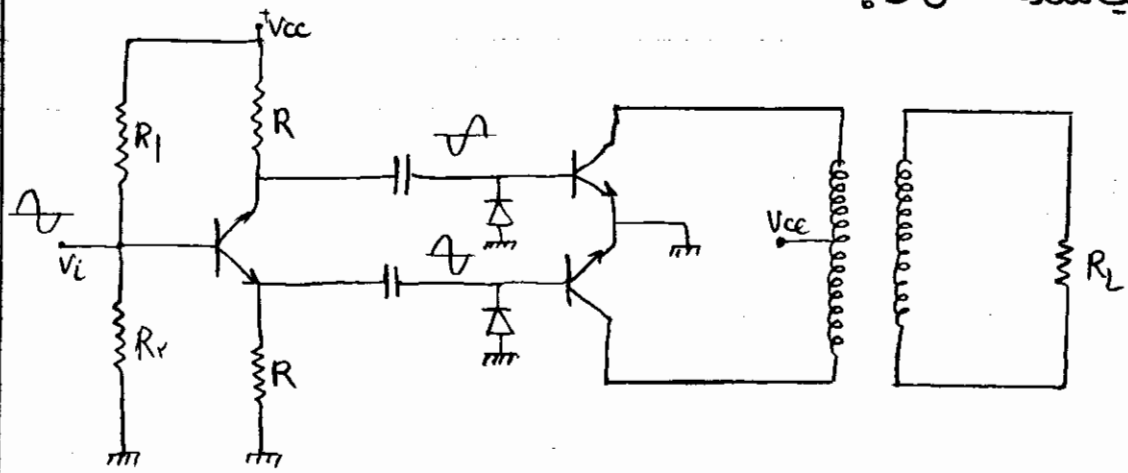
$$V_m = \frac{r V_{cc}}{\pi} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P_{Qmax} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R'_L} \\ R_L = \frac{r}{\pi^2} \cdot \frac{V_{cc}}{R'_L} \\ P_S = \frac{r}{\pi^2} \cdot \frac{V_{cc}^2}{R'_L} \end{array} \right\} \rightarrow \eta = 50\%$$

$$\rightarrow P_{Qmax} = \% \text{ II } P_{Lmax} = \% \text{ II } P_{Smax}$$

$V_m = V_{cc}$



بایاس تقویت کننده کلاس B :

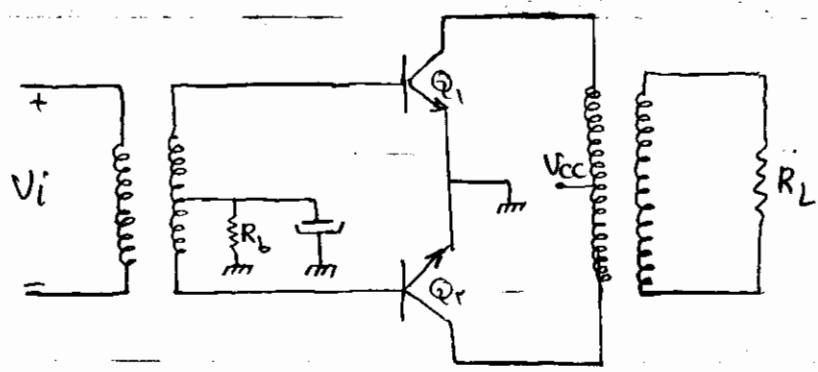


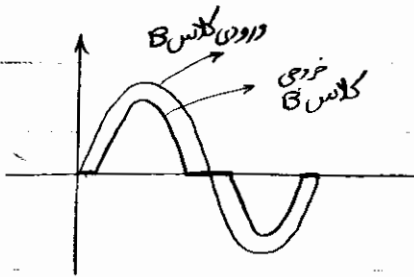
در حالتی که دیودها در مدار بالا وجود ندارند مدار پس از چند آلترنانس خاموش می شود چون

مسیری برای دشارژ شدن خازن ها وجود ندارد. لذا برای رفع این مشکل از دو دیود به شکل بالا

استفاده می شود تا مسیر دشارژ خازن ها فراهم شود.

تقویت کننده پوش پول کلاس AB :

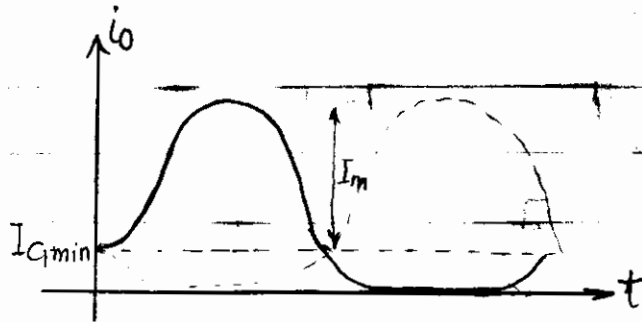




در تقویت کننده کلاس B مقداری از سیگنال ورودی صرف

روشن کردن ترانزیستورها می شود برای رفع این اشکال

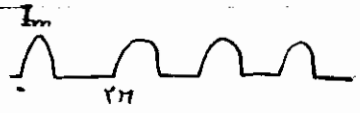
از کلاس AB استفاده می کنیم. در این کلاس ترانزیستورها را کمی بایاس می کنیم و در نتیجه در آستانه



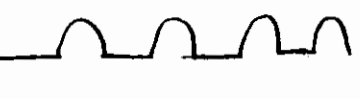
هدایت خواهند بود.

$$V_i = 0 \rightarrow I_s = 2I_{c_{min}}$$

$$i_{c1} = I_m \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin \omega t - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos \omega t}{1 \times 3} + \frac{\cos \omega t}{3 \times 5} + \dots \right) \right)$$



$$i_{c2} = I_m \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2} \sin \omega t - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos \omega t}{1 \times 3} - \frac{\cos \omega t}{3 \times 5} + \dots \right) \right)$$

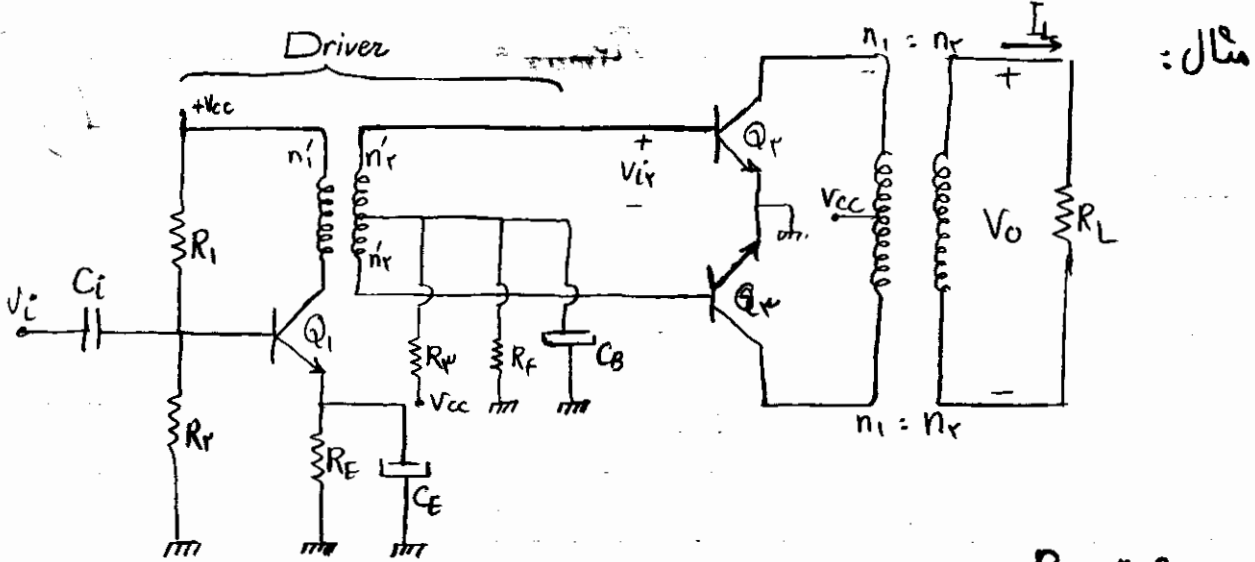


$$\rightarrow i_L = \frac{n_1}{n_2} (i_{c1} - i_{c2}) = \frac{n_1}{n_2} (I_m \sin \omega t)$$

از مزایای کلاس B و AB تقویت کننده پوش پول غیر از بلندمان بالا این است که بوسیله کوپلر

ترانسفورماتوری مانند یک فیلتر عمل می کند و هارمونیک های زوج را در جریان خروجی حذف

می کند.



مثال:

$R_L = 8 \Omega$

$\beta_1 = h_{fe1} = 100$, $h_{fev} = h_{fev} = \beta_p = \beta_n = \Delta$, $V_{cc} = 20$

$V_{CEsat} = 1V$, $V_{BE(cutin)} = 0.7V$, $V_{BEmax} = 1.8V$

Driver طراحي $\frac{n_1}{n_2} = ?$ ← $P_{Lmax} = 10W$ (الف)

ب) P_{Qmax} , P_{Dmax} , P_{Tmax} و $f_L = 20Hz$ و فرکانس قطع پائين ترانسفورماتور

10Hz اي باشد (بدین معنی که باید از آنها صرف نظر کنیم)

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_m}{V_{om}}$, $P_{Lmax} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 10W \rightarrow V_{om} = 12.9V$

$V_m = V_{cc} - V_{CEsat} = 20 - 1 = 19V \rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{19}{12.9} = 1.47$

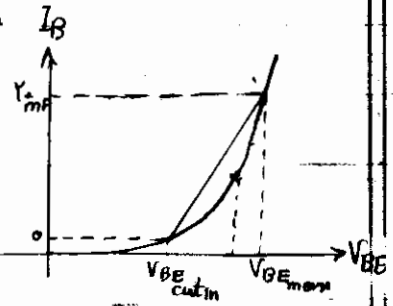
$V_{Bp} = V_{BE(cutin)} = \frac{R_f}{R_p + R_f} V_{cc} = 0.7V \rightarrow \frac{R_p}{R_f} = \frac{19}{1.3}$

if $R_f = 1k\Omega \rightarrow R_p = 14.6k\Omega$

$I_{Lmax} = \frac{V_{om}}{R_L} = \frac{12.9}{8} = 1.61A$, $I_{Cmax} = \frac{n_2}{n_1} I_{Lmax} = 1.09A$

$$I_{B_{max}} = \frac{I_{C_{max}}}{\beta_r} = 20 \mu A$$

$$V_{i_{rmax}} = \frac{V'_m}{A_{Vr}}$$



$$|A_{Vr}| = \frac{h_{fe} R'_L}{h_{ie_r}}, \quad h_{ie_{av}} = \frac{V_{BE_{max}} - V_{BE_{cutin}}}{I_{B_{max}} - I_{B_{min}}}$$

$$= \frac{19 - 10}{20 - 0} = 10 \Omega$$

$$\rightarrow |A_{Vr}| = \frac{h_{fe} \left(\frac{n_L}{n_r}\right)^r R_L}{h_{ie_{av}}} = 20$$

$$\rightarrow V_{i_{rmax}} = \frac{V'_m}{A_{Vr}} = \frac{19}{20} \approx 0.95 V = \Delta V_{BE}, \quad \frac{n'_i}{n'_r} = 10$$

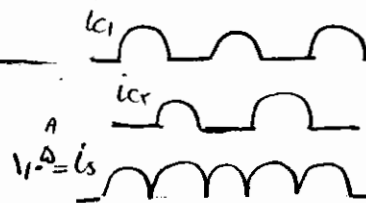
$$I_{C_{max}} \geq I_{B_{max}} \cdot \frac{n'_r}{n'_i} = 2 mA \quad \text{باید}$$

$$V_{CE1} \geq \frac{n_L}{n_r} \cdot V_{i_{rmax}} = 9.5 V$$

if $V_{CE1} = 10 V \rightarrow R_E I_C = 10 V, \quad I_C = 2 mA \rightarrow R_E = 5 k\Omega$
 RE انتخابی RE = 5V K

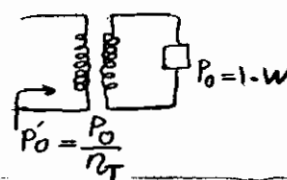
$$V_{B1} = 1.0 V, \quad R_1 = R_r = 10 k \rightarrow V_E = 9.5 V \rightarrow I_C = \frac{9.5}{5} = 1.9 mA$$

ب) $I_S = 1100 A$



$$P_{tmax} = \frac{V_{CE_{max}} I_{C_{max}}}{\pi} = 13.4 W$$

$$\eta_{max} = \frac{P_{o_{max}}}{P_{tmax}} = \frac{10}{13.4} = 0.746$$



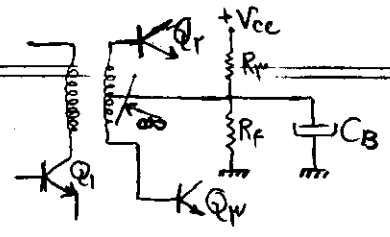
$$P_{Q_{max}} = 0.20 P_{L_{max}} = 2 W$$

$$\begin{cases} V_{CE_{max}} = V_{CC} = 10 V \\ I_{C_{1av}} = \frac{I_{C_{max}}}{\pi} = 1.19 mA \\ P_{Q} = 2 W \end{cases}$$

مشخصات ترانزیستور انتخابی:

$$R_{G_E} = R_E \parallel \left(\frac{R_1 \parallel R_r \parallel R_s + h_{ie}}{1 + h_{fe}} \right) \approx \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = 13 \Omega$$

$$R_{CB} = R_r \parallel R_f \approx 1K$$



$$R_{ci} = (R_i \parallel R_r \parallel h_{ie}) + R_s \approx 101 K\Omega$$

$$f_{CE} = 18 \text{ Hz}$$

با استفاده از روش قطب مسط:

$$f_{CB}, f_{ci} \approx 1 \text{ Hz}$$

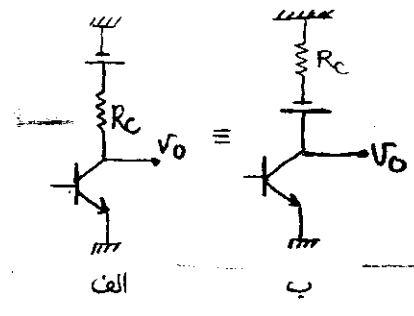
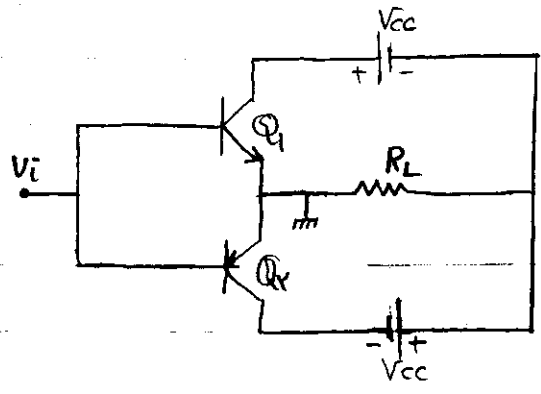
$$\rightarrow \frac{1}{2\pi R_{CE} \cdot C_E} = 18 \text{ Hz} \rightarrow C_E = 480 \mu F$$

$$1 \text{ Hz} = \frac{f'_L}{\sqrt{2k-1}} \rightarrow f'_L = 174 \text{ Hz}$$

$$C_i = \frac{1}{2\pi R_{ci} \cdot f'_L} = 224 \mu F$$

$$C_B = \frac{1}{2\pi R_{CB} \cdot f'_L} = 250 \mu F$$

$$\rightarrow C_i = C_B = 220 \mu F$$

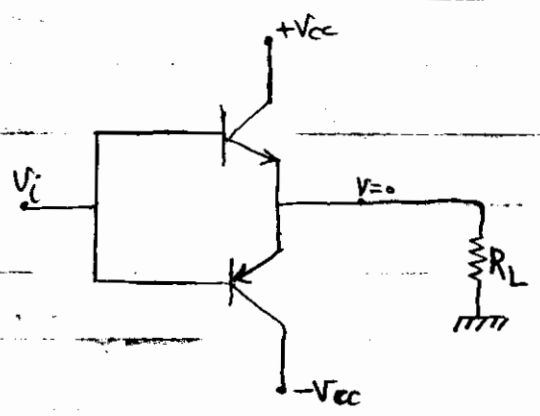


در این حالت چون منبع تغذیه ^{dc} Float است اگر نویزی در دوسران ظاهر شود از بین نخواهد رفت.

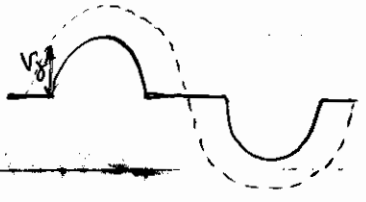
در شکل ب هم منبع تغذیه همین حالت را دارد ولی در حالت الف اگر نویز در دوسر منبع ظاهر شود

چون مقاومت داخلی منبع کم است نویز از بین رفته و به زمین منتقل می شود. لذا حالت بالا برای

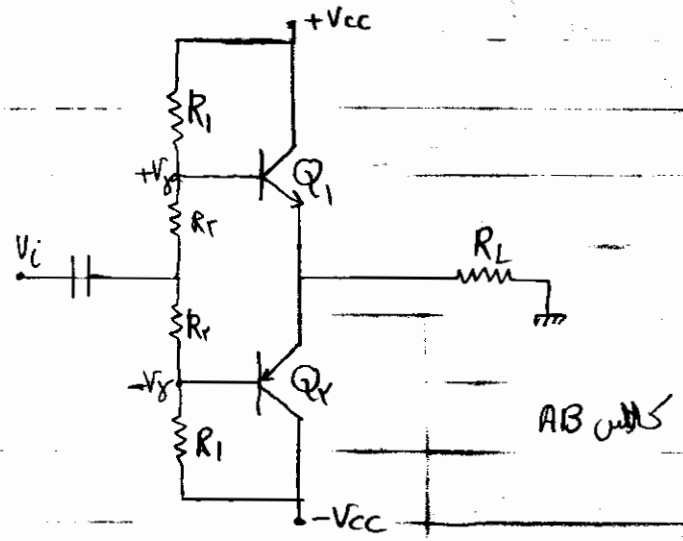
تقویت کننده مناسب نیست و باید آن را اصلاح کنیم:



برای رفع مشکل *distortion cross over* در تقویت کننده بالا



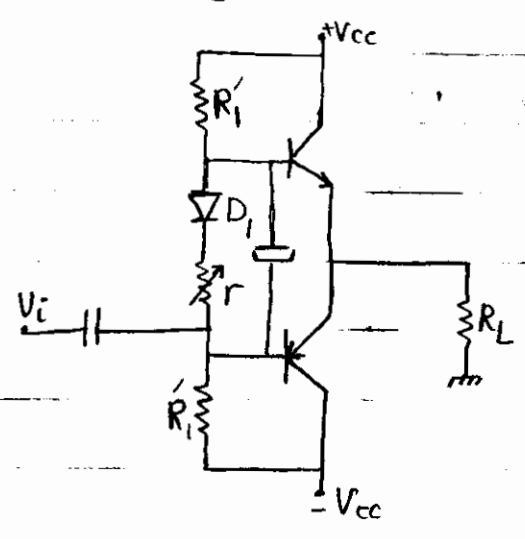
آن را به شکل زیر می بندیم :



برای رفع مشکل تغییر جریان در مدار بالا (تغییر جریان باعث تغییر ولتاژی شود) می توان به جای

R_r ها از دیود استفاده کرد اما چون $V_D > V_g$ است لذا تقویت کننده به سمت کلاس A

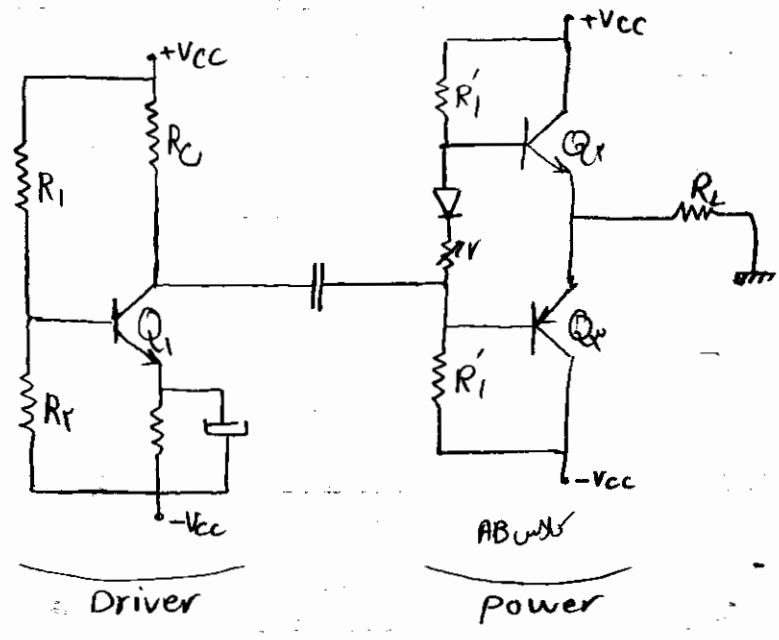
وروشن بودن بیشتر میلی کند. این مشکل را



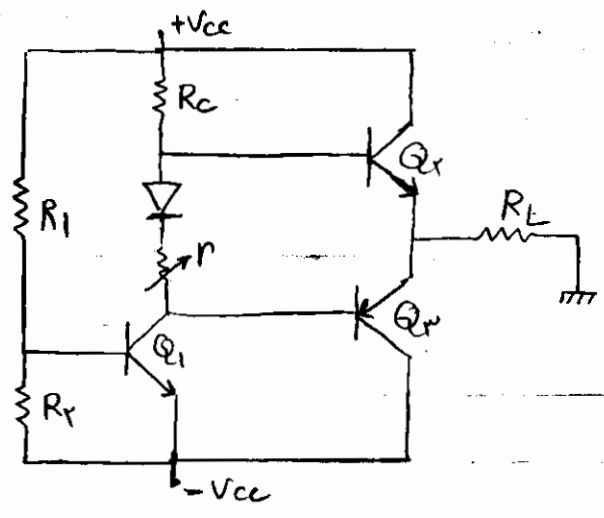
به صورت زیر حل می کنیم :

اگر مجموع مقاومتهای ۲ و ۳ در ورود باعث تغییر سیگنال در دو بیس ترانزیستورها شود از خازنی که در شکل

نشان داده شده است استفاده می کنیم.

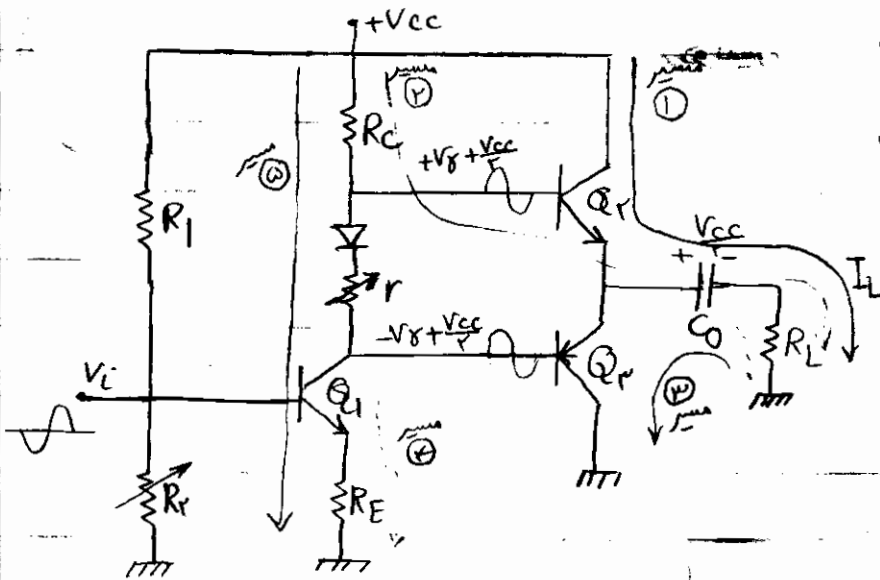


برای جلوگیری از استفاده المان زیاد:



اغلب چون در مدارها از یک منبع تغذیه V_{CC} استفاده می شود برای حذف منبع $-V_{CC}$ به شکل

زیر عمل می کنیم:



$$V_{CC} = V_{CE1} + V_{CE2} + R_L I_L$$

$$\frac{V_{CC}}{r} = V_{CE1} + R_L I_L$$

وجود خازن C_0 :

۱- به عنوان کوپلاژ در مدار به کاری رود و ۲- مثل منبع تغذیه را برای Q_2 بازی می کند.

مقاومت متغیر R_r برای بوجود آوردن سوئیچینگ متقارن در خروجی به کاری رود و با تغییر

مقاومت متغیر ۲، crossover را در خروجی تعیین می کنیم. یعنی مثلاً می توانیم کاری کنیم که در

لحظه ه ترانزیستورها روشن شوند.

$$V_{B1} = \frac{R_r}{R_1 + R_r} V_{CC} \quad , \quad I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{V_{B1} - V_{BE1}}{R_E}$$

$$V_{B2} = V_{CC} - R_C I_{C1}$$

$$V_{B3} = V_{CC} - (R_C I_{C1} + V_D + r I_{C1})$$

$$\rightarrow V_{B2} - V_{B3} = V_D + r I_{C1} = 2V_\gamma$$

$$V_{E2} = V_{E3} = V_{B2} - V_\gamma = \frac{V_{CC}}{r} = V_{CE0}$$

در بیک عمشبت خروجی $\rightarrow V_{CC} = R_C (I_{B_{rmax}} + I_{C_{1min}}) + V_{BE_{rmax}} + \frac{V_{CO}}{V_{CC}} + R_L I_{Lmax}$

در روشن و خاموش و بیست اشباع $I_{C_{1min}}$ را صفر در نظر نمی گیریم تا اثر از سیستورها به طور کامل خاموش نشوند.

$V_{CC} = V_{CE_{rmin}} + \frac{V_{CO}}{V_{CC}} + R_L I_{Lmax}$

در هنگام طراحی R_L و R_C را به ما می دهند در نتیجه به صورت زیر عمل می کنیم:

$P_L = \frac{V_{om}^2}{2R_L} \rightarrow V_{om} = R_L I_{Lmax} \rightarrow I_{Lmax}$ معلوم

و اگر $V_{CE_{rmin}}$ معلوم باشد می توان مقدار تغذیه مورد نظر (V_{CC}) را تعیین کرد. با معلوم بودن

V_{CC} در رابطه ① چون $V_{BE_{rmax}}$ جزو اطلاعات ورودی است و $I_{C_{1min}}$ را خود طراحی معلوم می کند

لذا فقط R_C مجهول خواهد بود و به این ترتیب R_C معلوم می شود. اما چون مقدار مشخص شده

عدد استاندارد نیست (اگر تست کنکور نبود) در حالت طراحی فرض می کنیم $I_{C_{1min}}$ صفر باشد.

سپس R_C را تعیین می کنیم. بعد آن را به سمت مقاومت استاندارد کمتری بریم به این ترتیب خود

به خود $I_{C_{1min}}$ در نظر گرفته می شود.

if $V_i = 0 \rightarrow \begin{cases} V_{R_C} = V_{CC} - (\frac{V_{CC}}{\beta} + V_{\gamma}) = R_C I_{C_1} \rightarrow I_{C_1} \text{ معلوم} \\ V_{B_r} - V_{B_p} = 2V_{\gamma} = V_{D_1} + r I_{C_1} \rightarrow r \text{ حدود آن را می یابیم.} \end{cases}$

در بیک منفی خروجی $\rightarrow \frac{V_{CC}}{\beta} = |V_{CE_{pmin}}| + R_L (I_{C_p}) \rightarrow I_{Lmax}$

در روشن و خاموش و بیست اشباع و I_{C_p} به سمت اشباع

با دقت در رابطه بالای بنیمیم که هیچ چیز محاسبه شده است فقط چک می کنیم که $V_{CE_{min}}$ که از رابطه

بالا پیدای شود از $V_{CE_{sat}}$ بزرگتر باشد در غیر این صورت طراحی را از اول تکرار می کنیم.

$$\begin{cases} \frac{V_{CC}}{\beta} = R_L I_{C_{max}} + |V_{BE_{max}}| + V_{CE_{sat}} + R_E [I_{B_{max}} + I_{C_{max}}] \\ V_{CC} = R_C I_{C_{max}} + V_D + r I_{C_{max}} + V_{CE_{sat}} + R_E [I_{B_{max}} + I_{C_{max}}] \end{cases}$$

* در این تقویت کننده ضرب پایداری را خیلی بزرگ (۹-۱۰) انتخاب نمی کنیم چون R_2 و R_1 کوچک

می شوند و ولتاژش ورودی کم می شود و اگر قرار باشد طبقه دیگری قبل از Driver قرار گیرد

طراحی آن مشکل می شود. لذا ضرب پایداری حرارتی را در حدود ۳-۴ انتخاب می کنیم.

اگر مقاومت R_E را با خازن C_E جایگزین کنیم:

در رابطه (۴) به جای $[I_{B_{max}} + I_{C_{max}}]$ مقدار I_{C_1} را قرار می دهیم و احتیاجی به

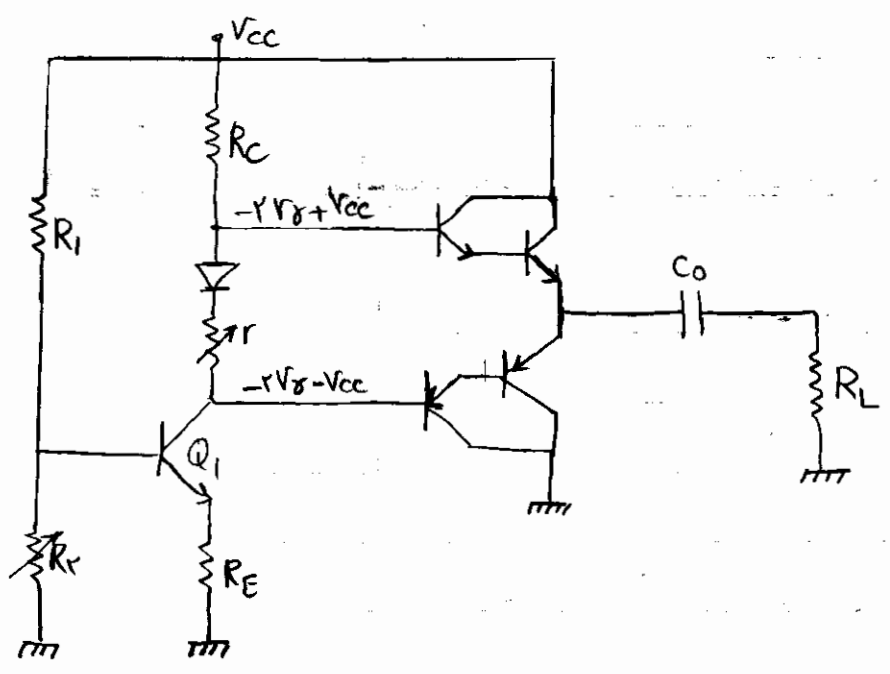
رابطه (۵) نخواهیم داشت ولی در صورت نوشتن (۵) باید به جای $I_{C_{max}}$ از I_{C_1} استفاده

کنیم که در این صورت $V_D + r I_{C_{max}}$ برابر $2V_T$ خواهد شد.

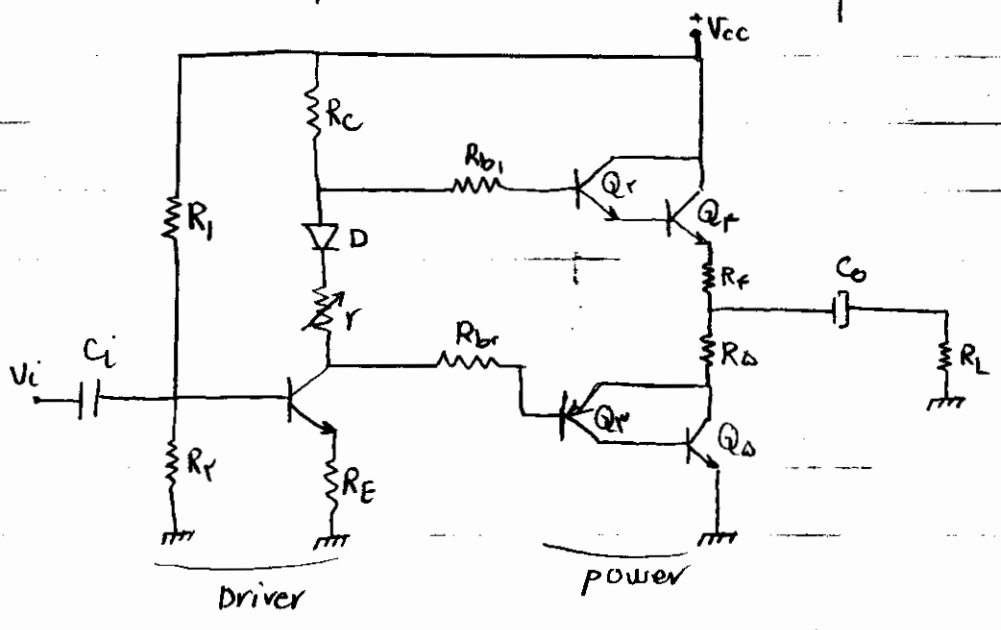
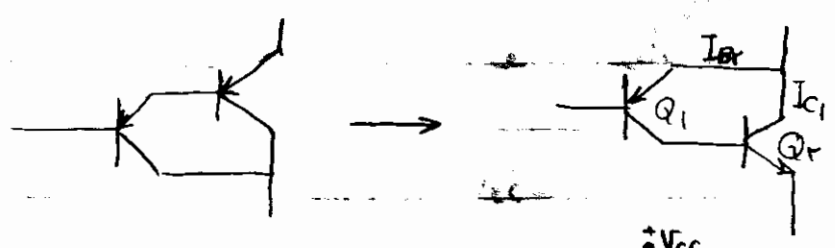
برای اخذ اسیس توان خروجی می توان به جای Q_2 و Q_3 از زوج در لایتون

$$2V_T + 2V_T =$$

استفاده می کنیم.



اما چون ضرایب تقویت ترانزیستورهای npn با pnp برابر نیست لذا باعث می شود که تقویت درست انجام نشود و مدار از حالت تقارن خارج شود. لذا به جای یکی از زوج های دارلینگتون از زوج زیر استفاده می کنیم:



در شکل بالا مقاومت‌های R_4 و R_5 مقاومت‌های محافظی هستند که اگر بار R_L اتصال کوتاه شود

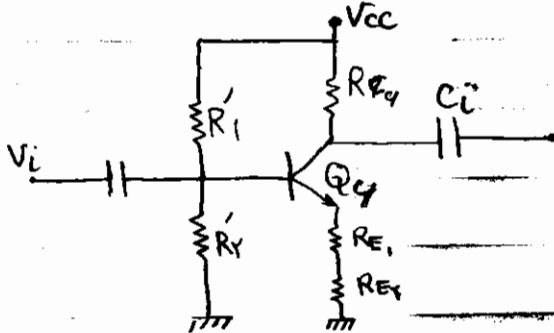
چون جریان زیادی از مدار می‌گذرد و باعث سوختن ترانزیستورها خواهد شد، لذا این مقاومت‌ها

را قدری ضخیم که مقدار کوچکی دارند تا هم تلف نشود و هم به محض عبور جریان زیاد

این مقاومت‌ها بسوزند. (سوختن مقاومت‌ها به صرفه‌تر از سوختن ترانزیستور است).

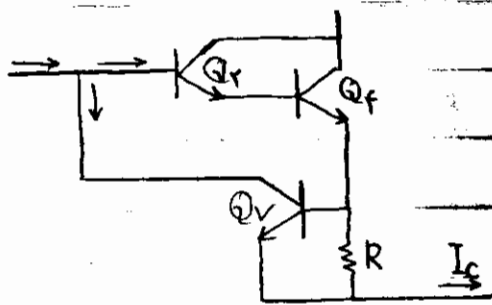
در تقویت کننده فوق چون سیگنال ورودی باید به اندازه کافی بزرگ باشد لذا در ورودی از

یک Pre Amp. استفاده می‌کنیم که به شکل زیر است:



I.C. مجتمع در مدارها معمولاً برای حفاظت جریانی از روشی که در بالا گفته شد استفاده نمی‌کنند بلکه مقدار

مقاومت‌ها را طوری انتخاب می‌کنند که جریان محدود شود. لذا از ترکیبی به فرم زیر استفاده می‌کنند:



طرح یک محدود کننده جریان

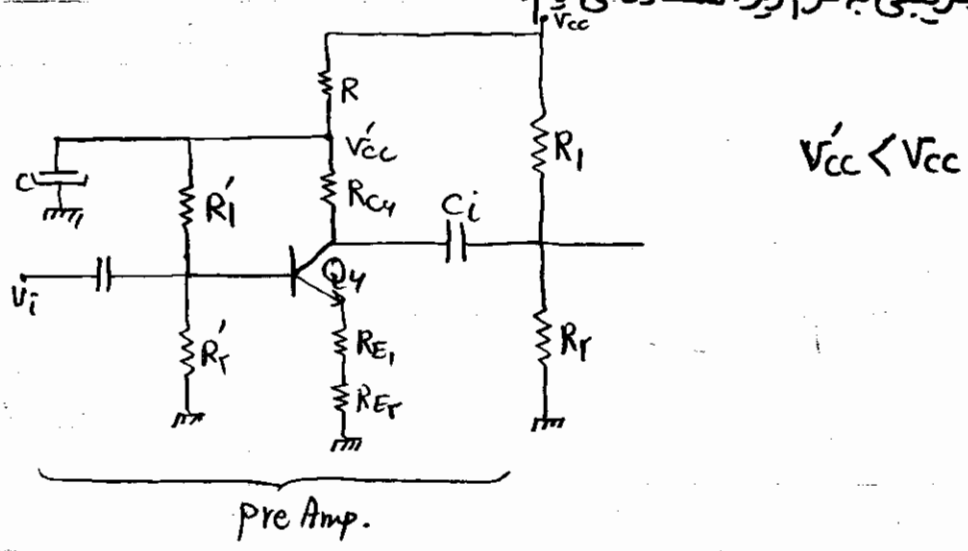
$V_{BE_{ON}} = R I_{Lmax}$: $V_{BE_{ON}}$ را طوری انتخاب می‌کنیم که :

در مدار محدود کننده فوق به محض اینکه I_c زیاد شود $R I_c$ زیاد شده و به $V_{BE_{on}}$ می رسد و

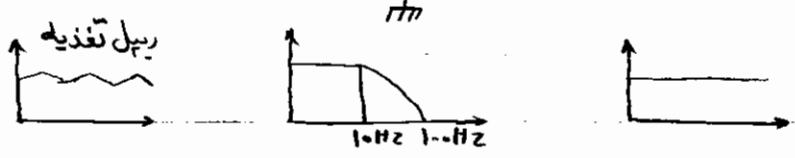
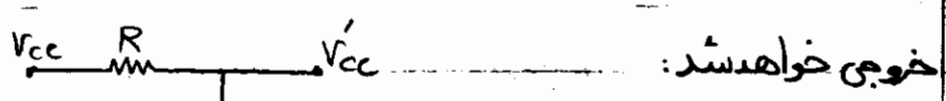
$R I_c$ روشن شده جریان را از بیس Q_2 کشیده و آن را محدود می کند.

برای اینکه در ترکیب Pre Amp از منبع تغذیه پائین استفاده کرده و تلفات این ترکیب را پائین

آوریم از ترکیبی به فرم زیر استفاده می کنیم:

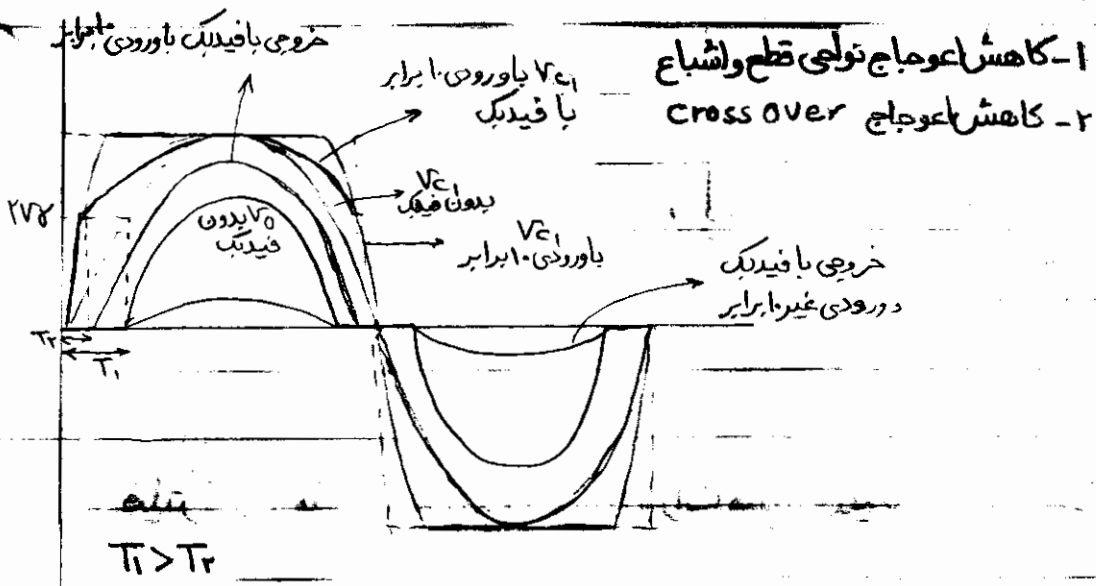
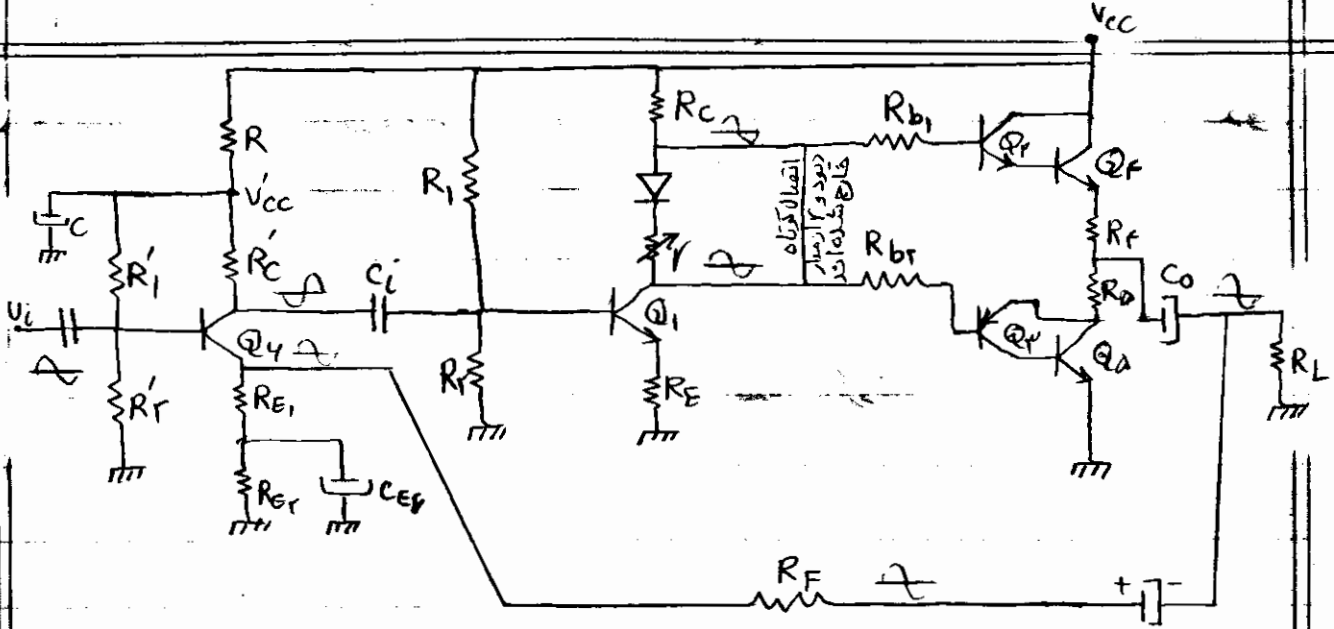


حسن دیگر ترکیب بالا فیلتر کردن منبع تغذیه است چون تغییرات منبع تغذیه باعث تغییرات

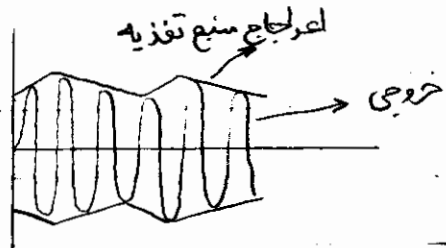


برای اینکه در تقویت کننده فوق هم حسن راندمان بالای کلاس B وهم حذف $over$ distortion

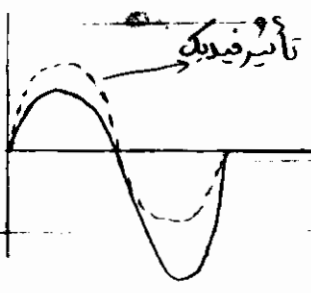
را داشته باشیم از یک ترکیب فیدبک استفاده می کنیم:

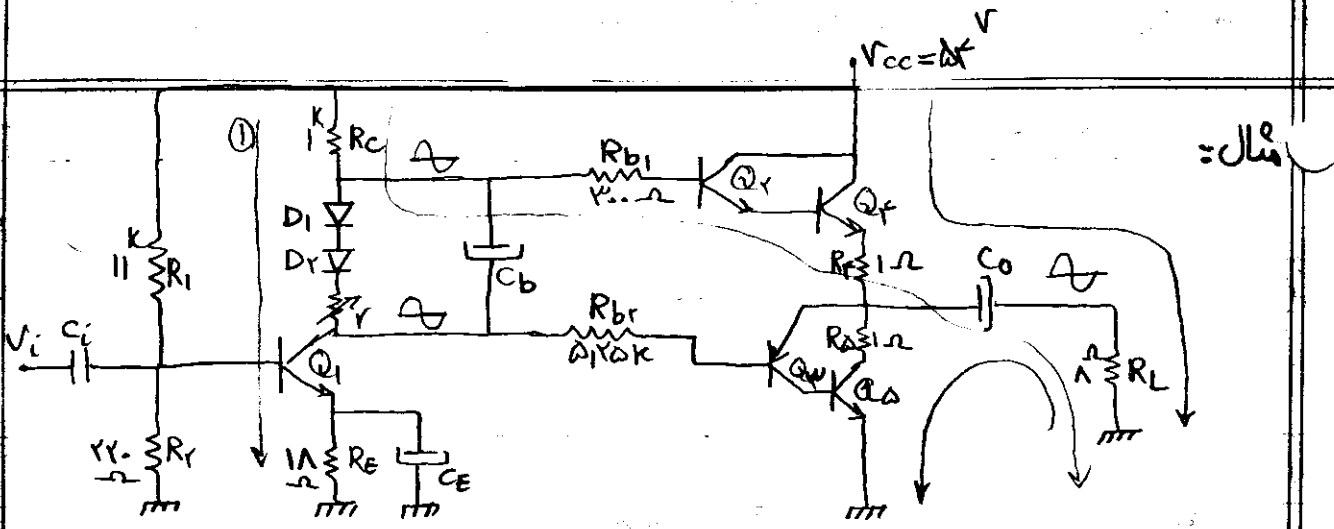


همچنین شبکه فیدبک باعث حذف ریبیل منبع تغذیه شده و از تغییرات خروجی جلوگیری می کند



نحوه کاهش اعوجاج نولوی قطع و اشباع:





مثال

$Q_1 : V_{BE} = 0.7, \beta = h_{fe} = 100, V_{CEsat} = 1V$

$Q_2, Q_3 : |V_{BE_{cut-in}}| = 0.7, |V_{BE_{max}}| = 1V, \beta = h_{fe} = 40$

$Q_4, Q_5 : V_{BE_{cut-in}} = 0.7, V_{BE_{max}} = 1V, \beta = h_{fe} = 50$

$D_1, D_2 : V_D = 0.7$

محاسبه کنید:

$P_{so} = ?$ با شرط $V_i = 0$

الف) نقطه کار Q_1

$P_{RF, D}, L_{max}, A_p = \frac{P_{Omax}}{P_{Imin}}, P_{Lmax}, I_{Cmax}, P_{Qmax}$

ت) $f_L = 20Hz, C = ?$

$V_{B1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 11.04$ با فرض باز بودن بیس Q_2, Q_3

$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = 20.1 \text{ mA}$

$V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = [V_{CC} - (R_C I_{C1} + 2V_D + r I_{C1})] - R_E I_{C1}$

$V_{B2} = V_{CC} - R_C I_{C1} = 11.17 \text{ V}$

$V_{CE1} = 14.1 \text{ V}$

$V_{B3} = V_{B2} - (2V_D + r I_{C1}) = 14.9 \text{ V}$

$\rightarrow \boxed{V_{B2} - V_{B3} = 1.15 \text{ V}}$ پوش بیس کلکتس AB :

پس تقویت کننده پوش بول کلاس AB است و وصل کردن بیس Q_2 و Q_3 تأثیر در نقاط کار نخواهد داشت چون جریان کمی از آنها می گذرد. بیس بیس ما را وصل می کنیم.

$$V_{CO} = V_{B_2} - 2V_{BE_{cutin}} = 2.714 \text{ V}$$

$$P_{S_0} = V_{CC} (I_{C_1} + I_{R_1, R_2}) = 1.95 \text{ W}$$

تلفات درایور بدون ورودی

$$KVL: V_{CC} = R_C (I_{C_1 \min} + I_{B_2 \max}) + V_{BE_2 \max} + V_{BE_1 \max} + R_F I_{C_F \max} + V_{CO} + R_L I_{C_F \max} + R_{B_1} I_{B_2 \max}$$

برای اینکه Q_1 در ناحیه قطع کاملاً خاموش نشود فرض می کنیم که در طراحی $I_{C_1 \min}$ برابر 1 mA در نظر گرفته شده است.

$$\rightarrow I_{C_F \max} = 2.14 \text{ A} \quad I_{C_F \max} = \frac{I_{C_F}}{\beta_F} = 52 \text{ mA}$$

$$\rightarrow V_{O \max} = R_L \cdot I_{C_F \max} = 20.18 \text{ V}$$

در بیک آنترناس مثبت

$$KVL: V_{CC} = V_{CE_F} + R_F I_{C_F \max} + V_{CO} + R_L I_{C_F \max}$$

تحت شرایط بالا V_{CE_F} را محاسبه می کنیم:
در بیک آنترناس مثبت:

$$\rightarrow V_{CE_F} = 3.12 \text{ V}$$

پس Q_2 به اشباع نرسیده است و محاسبات درست بود

$$V_{CE_2} + V_{BE_2 \max} = V_{CE_F} \rightarrow V_{CE_2} = 2.14$$

باتوجه به زوج طراحی که معلوم بود که Q_2 به اشباع نمی رفت.

$$V_{CO} = R_L \cdot I_{C_{O \max}} + |V_{BE_2 \max}| + R_{B_2} I_{B_2 \max} + V_{CE_1 \min} + R_E I_{C_1}$$

در بیک آنترناس منفی:
در I_{C_1} صرف نظر کردیم:

$$\rightarrow I_{C_{O \max}} = 2.14 \text{ A} \quad \rightarrow I_{C_F \max} = \frac{I_{C_O}}{\beta_D} = 52.4 \text{ mA}$$

$$\rightarrow V_{O \max} = R_L \cdot I_{C_{O \max}} = 21.44 \text{ V}$$

در بیک آنترناس منفی

باتوجه به V_{0max} منفی مثبت $\rightarrow I_{Cmax} = I_{Cfmax} = 2.4 A$

$\rightarrow V_{CO} = R_L I_{Lmax} + R_D I_{Lmax} + V_{CE\Delta} \rightarrow V_{CE\Delta} = 3.28 V$

$V_{CEp} + V_{BE\Delta} = R_D I_{Lmax} + \frac{1}{2} V_{CE\Delta} \rightarrow |V_{CEp}| = 5.10 V$

$P_{Lmax} = \frac{R_L \cdot I_{Lmax}^2}{2} = 27 W$

$P_{Q_{\Delta}}^{max} = \left(\frac{1}{\Delta}\right) \cdot \left[\frac{R_L \cdot I_{Lmax}^2}{2} + \frac{R_F \cdot I_{Lmax}^2}{2}\right] = 41.08 W$

$P_{Q_{r,r}} = \frac{P_{Qf}}{\beta_f} = 122 mW$ با فرض برابری V_{CE} برای Q_r و Q_f

$P_{Q_{i,max}}^{کلاس A} = V_{CE} \cdot I_C = 48.0 mW$ ، $I_{Cmax} = \sqrt{I_{C1}}$ (نقطه کار در حالت)

① مسير KVL : $V_{CC} = R_C I_{Cmax} + 3V_{BEcutin} + V_{CEsat} + R_E I_{C1}$ دیک اتزان منفی

$P_{i,max} = \frac{V_{i,max}^2}{2 R_i}$

$A_V = A_{V_{Driver}} \times A_{V_{pushpull}}$

$A_{V_{D1}} = A_{V_i} = \frac{-h_{fe} \cdot R'_L}{h_{ie} \approx r_{i1}}$

در یک مثبت : $R'_L = R_{C1} \parallel [R_{b1} + h_{ier} + (1+h_{fer})h_{ief} + (R_f + R_L)(\beta_r \beta_f)] \approx 1k$ با تقریب منفی

$\rightarrow A_{V_i}^+ = 500$

در یک منفی : $R'_L = R_{C1} \parallel [R_{b1} + h_{ier} + R_L \beta_r \beta_f \parallel (R_D + r_{oes})] = R_{C1}$

$$R_0 = R_f + \frac{R_{b1}}{\beta + \beta_r} = 111 \Omega \rightarrow A_{V_{pushpull}}^+ = \frac{R_L}{R_L + R_0^+} =$$

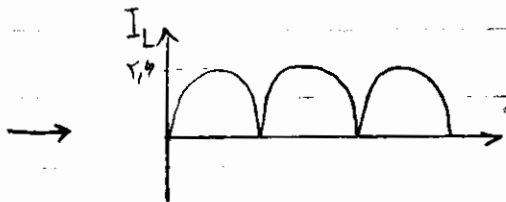
$$R_0^- = \frac{R_{br} + h_{ier}^{\circ}}{\beta_r \beta_0} = 1175 \Omega \rightarrow A_{V_{pushpull}}^- = \frac{R_L}{R_L + R_0^-} =$$

$$\rightarrow |A_V|^+ = A_{V_D}^+ \cdot A_{V_P}^+ = 439$$

$$|A_V|^- = A_{V_D}^- \cdot A_{V_P}^- = 410$$

$$\rightarrow V_{i_{max}} = \frac{V_{o_{max}}}{A_{V_{min}}} = 50 \text{ mV} \rightarrow P_{i_{max}} = 17.5 \mu\text{W}$$

$$\rightarrow A_p = \frac{P_{L_{max}}}{P_{i_{max}}} = 2 \times 10^4 \quad \text{ب} \quad 10 \log A_p = 43 \text{ dB}$$



$$P_{R_f} = \left(\frac{I_m}{r_{R_f}} \right) \times \frac{l}{r} = 1.04 \text{ W}$$

$$R_{Ci} = R_i \parallel R_r \parallel h_{ie1} + R_s^{\circ} = 100 \Omega$$

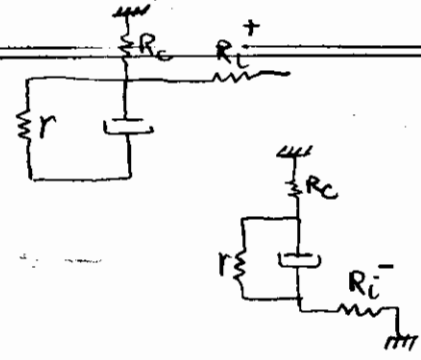
$$R_{CE} = R_E \parallel \left[\frac{1}{h_{fe} + 1} (h_{ie}) \right] \approx \frac{h_{ie1}}{h_{fe1}} = 1.18 \Omega$$

چون C در هر آنترناس یک مقاومت مای بیند لذا در هر آنترناس مقاومت را حساب می کنیم

و مقاومت کمتر را که فرکانس قطع بالاتر تولیدی کند انتخاب می کنیم:

در آلترا نوس مثبت : $R_{cb}^+ = r$

در آلترا نوس منفی : $R_{cb}^- = r \parallel [R_c + R_i] \approx r$



$\rightarrow R_{ci} = r$

مراحل بالا را برای خازن C_c نیز انجام می دهیم:

$R_{co}^+ = (R_o^+ + \frac{R_c}{\beta_r \beta_f}) + R_L$

$\rightarrow R_{co} \approx 10 \Omega$ با انتخاب مقاومت کمتر

$R_{co}^- = (R_o^- + \frac{R_c}{\beta_r \beta_D}) + R_L$

$f_L = \frac{f'_L}{\sqrt{r k_f - 1}}$

$\rightarrow f'_L = 10 \text{ Hz}$

- $C_E = 4300 \mu\text{F}$
- $C_i = 140 \mu\text{F}$
- $C_b = 1300 \mu\text{F}$
- $C_o = 140 \mu\text{F}$

تقویت کننده اختلاف:



در حالت ایده آل : $V_o = A_d \cdot (V_{i1} - V_{i2})$

در حالت واقعی : $V_o = A_d (V_{i1} - V_{i2}) + A_c (\frac{V_{i1} + V_{i2}}{2})$

با قراردادن یک دیود زتر در ورودی کم حساس به دما است به فرض باز یاد شدن دما V_o مثبت شده و با کم شدن آن V_o منفی است و به عنوان ترموستات می توان از آن استفاده کرد.

با توجه به این که این تقویت کننده باید در فرکانسهای پایین را نیز تقویت کند لذا اغلب باید